### ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

Patent number:

JP2002124389

**Publication date:** 

2002-04-26

Inventor:

SAKAKIBARA MITSUHIKO; YASUDA HIROYUKI; NEGORO

YASUNORI

Applicant:

JSR CORP; FUTABA DENSHI KOGYO KK; KOKUSAI KIBAN

ZAIRYO KENKYUSHO

Classification:

international:

C08F12/26; C08F20/34; C08F20/60; C08F26/06; C09K11/06; H05B33/14; H05B33/22; C08F12/00; C08F20/00; C08F26/00; C09K11/06; H05B33/14; H05B33/22; (IPC1-7): H05B33/22; C08F12/26; C08F20/34; C08F20/60; C08F26/06; C09K11/06;

H05B33/14

- european:

Application number: JP20000314940 20001016 Priority number(s): JP20000314940 20001016

Report a data error here

#### Abstract of JP2002124389

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element that has low starting voltage of luminance and high luminous efficiency, and is superior in durability. SOLUTION: The organic electroluminescent element comprises a positive hole transport layer that contains a carbazole system polymer having a structure unit as expressed in Formula (I). In the Formula, R1 expresses hydrogen atom, alkyl group or phenyl group, R2, R3, R4 and R5 each independently expresses hydrogen atom, alkyl group, alkoxyl group, phenyl group or dialkylamino group, and X expresses a single bond or a phenylene group, carbonyl group, or a bivalent organic group containing one or both of these.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list
1 family member for:
JP2002124389
Derived from 1 application.

→ Back to JP200212438

1 ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT Publication info: JP2002124389 A - 2002-04-26

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開2002-124389

(P2002-124389A)

(43) 公開日 平成14年4月26日(2002.4.26)

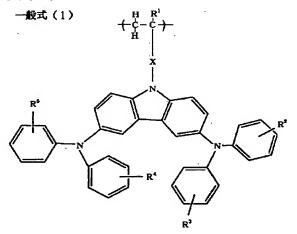
(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI				テーマコート・	(参考)
H05B 33/22				D 3K007			
CO8F 12/26		CO8F 12/26		4J100			
20/34	·	20/34	•				
20/60		20/60					
26/06		26/06					
	審査請求	未請求 請求	項の数3	OL	(全15頁)	最終頁	に続く
(21)出願番号	特願2000-314940(P2000-314940)	(71)出願人	00000417	'8			
			ジェイエ	スアー	ル株式会社		
(22)出願日	平成12年10月16日(2000.10.16)		東京都中	央区築	地2丁目11智	₿24号	
		(71)出願人					
			双葉電子				
			千葉県茂	原市大	芝629		
		(71)出願人	59711427	0			
					盤材料研究所		
					高津区坂戸:	3丁目2番	<b>針1号</b>
		(74)代理人	10007875	4	·		
			弁理士	大井	正彦		
	•					最終頁	に続く

## (54) 【発明の名称】有機エレクトロルミネッセンス素子

#### (57) 【要約】 (修正有)

【課題】 発光開始電圧が低く、発光効率が高く、しかも、耐久性に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する。

【解決手段】 一般式(1)で表される構造単位を有するカルバゾール系重合体を含有してなる正孔輸送層を具えてなる。



[R'] は水素原子、アルキル基またはフェニル基、 R' 、 R' 、 R' および R' は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、フェニル基またはジアルキルア、ミノ基、 X は、単結合、あるいはフェニレン基、カルボニル基またはこれらの一方若しくは両方を含有する 2 価の有機基を示す。〕

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1) で表される構造単位を 有するカルバゾール系重合体を含有してなる正孔輸送層 を具えてなることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化1】

〔式中、R'は水素原子、アルキル基またはフェニル基 20 を示し、R'、R'、R'およびR'は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、フェニル基またはジアルキルアミノ基を示す。 X は、単結合、あるいはフェニレン基、カルボニル基またはこれらの一方若しくは両方を含有する 2 価の有機基を示す。〕

【請求項2】 カルバゾール系重合体は、一般式(1) で表される構造単位を5質量%以上含有することを特徴とする請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 正孔輸送層は、一般式(1)で表される構造単位を有するカルバゾール系重合体と、当該カルバゾール系重合体と外の重合体とを含有してなり、当該正孔輸送層を構成する全重合体における一般式(1)で表される構造単位の割合が5質量%以上であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロル ミネッセンス素子に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、エレクトロルミネッセンス素子を構成する正孔輸送材料や電子輸送材料として、有機材料が使用され始めており、このような有機材料を使用した有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、「有機EL素子」ともいう。)の研究が活発に行われている。かかる有機EL素子を構成する有機材料においては、優れた耐久性を有するものであること、高い発光効率が得られるものであることが要求される。

【0003】従来、正孔輸送性能を有する有機材料としては、ジアミン誘導体、N,N'ージフェニルーN,N'ージ(3ーメチルフェニル)ー4,4',ジアミノビフェニル(以下、「mーTPD」ともいう。)などの芳香族アミン系化合物などの低分子有機材料、ポリビニルカルバゾールなどの高分子有機材料は、物理的または熱的な耐久性に乏しいものであるため、当該低分子有機材料により正孔輸送層を構成する場合には、有機EL素子の駆動中または保存中に当該正孔輸送層が変質してしまう、という欠点がある。また、ポリビニルカルバゾールなどの高分子有機材料は、ガラス転移点(Tg)が非常に高いものであるので、優れた耐久性、すなわち長い使用寿命を有する正孔輸送層が得られるが、発光開始電圧が非常に高く、また、正孔輸送性能が十分なものではないた

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、その目的は、発光開始電圧が低く、発光効率が高く、しかも、耐久性 に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子を提供することにある。

めに発光効率が低く、実用上問題がある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、下記一般式(1)で表される構造単位を有するカルバゾール系重合体を含有してなる正孔輸送層を具えてなることを特徴とする。

[0006]

[化2]

【0007】(式中、R'は水素原子、アルキル基またはフェニル基を示し、R'、R'、R'およびR'は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、フェニル基またはジアルキルアミノ基を示す。Xは、単結合、あるいはフェニレン基、カルボニル基またはこれらの一方若しくは両方を含有する2価の有機基を示す。】

【0008】本説明の有機エレクトロルミネッセンス素子においては、前記カルバゾール系重合体は、上記一般式(1)で表される構造単位を5質量%以上含有することが好ましい。また、前記正孔輸送層は、上記一般式(1)で表される構造単位を有するカルバゾール系重合体と、当該カルバゾール系重合体以外の重合体とを含有してなるものである場合には、当該正孔輸送層を構成する全重合体における一般式(1)で表される構造単位の割合が5質量%以上であることが好ましい。また、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも陽極層と、前記正孔輸送層と、発光層と、陰極層とを有することが好ましい。

#### [0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明する。図1は、本発明の第1の実施の形態に係る有機エレクトロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図である。この有機EL素子においては、透明基板1上に、陽極層(ホール注入電極層)2が設けられ、この陽極層2上には、正孔輸送層10が設けられ、この正孔輸送層1-0上には、発光層15が設けられ、この発光層15上には、陰極層(電子注入電極層)3が設けられている。そして、陽極層2および陰極層3は直流電源5に接続されている。

【0010】透明基板1としては、ガラス基板、透明性特に限定されるものではないが、ジメチルアミノ基、ジ 樹脂基板、石英ガラス基板などを用いることができる。 エチルアミノ基、ジプロピルアミノ基などの炭素数が1  $\sim 8$  のアルキル基を有するものが好ましく、特に、高い上)材料よりなるもの、例えば1 T O 膜、酸化スズ(S 50 正孔輸送性能が得られる点では、ジーn - プロピルアミ

nO,)膜、酸化銅(CuO)膜、酸化亜鉛(ZnO)膜などを用いることができる。正孔輸送層10は、上記一般式(1)で表される構造単位(以下、「特定構造単20位」という。)を有するカルバゾール系重合体(以下、「特定のカルバゾール系重合体」ともいう。)を含有してなるものである。

【0011】特定構造単位を示す一般式(1)において、R'は水素原子、アルキル基またはフェニル基を示す。ここで、アルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、プチル基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基などの炭素数1~18のアルキル基が挙げられる。そして、一般式(1)においてR'としては、メチル基、エチル基などの炭素数1~3のアルキル30基、水素原子が好ましい。

【0012】また、一般式(1)におけるR'、R'、 R' およびR' は、水素原子、アルキル基、アルコキシ 基、フェニル基またはジアルキルアミノ基を示し、全部 が同一のものであっても、その一部または全部が異なっ たものであってもよい。ここで、アルキル基としては、 特に限定されるものではないが、メチル基、エチル基、 プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、オクチル基などの 炭素数が1~8のアルキル基が好ましい。特に、高い正 孔輸送性能が得られる点では、メチル基が好ましく、有 機溶剤に対して高い溶解性を有する重合体が得られる点 では、炭素数が大きい(例えば炭素数が8)アルキル基 が好ましい。アルコキシ基としては、特に限定されるも のではないが、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ 基、プトキシ基などの炭素数が1~8のアルコキシ基が 好ましく、特に、高い正孔輸送性能が得られる点では、 メトキシ基が好ましい。ジアルキルアミノ基としては、 特に限定されるものではないが、ジメチルアミノ基、ジ エチルアミノ基、ジプロピルアミノ基などの炭素数が1 ~8のアルキル基を有するものが好ましく、特に、高い

【化3】

式(イ)

ノ基、ジーi-プロピルアミノ基が好ましい。そして、 一般式(1)において、R'およびR'の組み合わせと しては、両者のいずれか一方が水素原子であって、他方 がアルキル基であるもの、またR' およびR' の組み合 わせとしては、両者のいずれか一方が水素原子であっ て、他方がアルキル基であるものが好ましい。また、R <sup>1</sup> ~ R<sup>5</sup> の各々が、水素原子以外のものである場合に は、それぞれの位置はメタ位またはパラ位であることが 好ましい。

いはフェニレン基、カルポニル基またはこれらの一方若 しくは両方を含有する2価の有機基を示す。カルボニル 基を含有する2価の有機基としては、例えば-COO-で表される基(オキシカルボニル基)、-CONH-で 表される基(イミノカルボニル基)または-CONHC 〇-で表される基(ウレイレン基)が挙げられる。フェ ニレン基を含有する2価の有機基としては、例えば-C 、H、CH、O-で表される基が挙げられる。また、カ ルポニル基およびフェニレン基の両方を含有する2価の たは下記式(ロ)で表される基が挙げられる。ここで、 フェニレン基およびこれを含有する2価の有機基は、o -体、m-体、p-体のいずれであってもよいが、p-体であることが好ましい。そして、一般式(1)におい てXとしては、式(イ)で表される基、式(ロ)で表さ れる基、フェニレン基が好ましい。

[0014]

[0018]【化5】

般式(2)  $CH_2 = CR^1$ 

【0019】〔式中、R'は水素原子、アルキル基また はフェニル基を示し、R'、R'、R'およびR'は、 それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、 フェニル基またはジアルキルアミノ基を示す。Xは、単 結合、あるいはフェニレン基、カルボニル基またはこれ らの一方若しくは両方を含有する2価の有機基を示 す。)

[0020]

[化6]

【0021】 【化7】

【0022】このような特定単量体は、例えばカルバゾールを出発物質として、当該カルバゾールの窒素に結合 する水素原子並びに3および6の位置番号の各炭素原子に結合する水素原子に対して種々の置換反応を行うことにより得られる。具体的な一例として、上記式(a)で表されるカルバゾール誘導体の製造方法を説明すると、先ず、カルバゾールに、例えばニトロベンゼンを反応させることにより、当該カルバゾールの窒素に結合する水素原子をニトロフェニル基に置換し、さらに、例えば臭素を反応させることにより、3および6の位置番号の各炭素原子に結合する水素原子を臭素原子に置換し、これにより、中間生成物(A)(3,6ージプロム[Nー40(pーニトロフェニル)カルバゾール])を得る。この合成工程を、反応式(i)に示す。

[0023] [化8]

反応式(i)

中間生成物 (A)

9
H
N
C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NO<sub>2</sub>
NO<sub>2</sub>
NO<sub>2</sub>
NO<sub>2</sub>
NO<sub>2</sub>

【0024】このようにして得られる中間生成物(A)に、例えばmートリルフェニルアミンを反応させることにより、臭素原子をトリルフェニルアミノ基に置換することにより中間生成物(B)(3,6ーピス(mートリルフェニルアミノ) [Nー(pーニトロフェニル)カルバゾール])を得、更に、例えば中間生成物(B)に対して水素添加反応を行うことにより、ニトロ基をアミノ基に変換し、中間生成物(C)(3,6ーピス(mートリルフェニルアミノ) [Nー(pーアミノフェニル)カ10 ルパゾール])を得る。この合成工程を、反応式(ii)および反応式(iii)に示す。

[0025] [化9]

[0026]

【0027】そして、得られる中間生成物(C)に、例えばメタクリロイルクロライドを反応させることにより、式(a)で表されるカルバゾール誘導体を製造することができる。

【0028】また、式(b)で表されるカルバゾール誘導体を製造する方法を説明すると、上記式(a)で表されるカルバゾール誘導体の製造方法と同様にして、カルバゾールを出発物質として上記中間生成物(C)を合成40し、当該中間生成物(C)に、例えば2-イソシアナートエチルメタクリレートを反応させることにより、式(b)で表されるカルバゾール誘導体を製造することができる。

【0029】特定のカルバゾール系重合体は、特定構造 単位のみよりなるもの、すなわち特定単量体の単独重合 体であっても、特定構造単位と他の構造単位とを有する もの、すなわち特定単量体と、これと共重合可能な単量 体(以下、「共重合性単量体」という。)との共重合体 であってもよい。 【0030】特定のカルバゾール系重合体が、特定単量体と共重合性単量体との共重合体である場合には、特定構造単位の含有割合が5質量%以上、特に10質量%以上であることが好ましい。特定構造単位の含有割合が5質量%未満である場合には、得られる正孔輸送層10は、正孔輸送性能および耐久性が低いものとなりやすい

40 【0031】かかる共重合性単量体としては、例えばNーピニルカルバゾール、Nー(4ーピニルフェニル)カルバゾール、Nーピフェニルピニルカルバゾールなどの特定単量体以外のカルバゾール誘導体、下記式(e)で表される化合物、下記式(f)で表される化合物、下記式(g)で表される化合物などのピニル芳香族アミン類、pーピニルトリフェニルアミン、pーメタクリロイルトリフェニルアミンなどの正孔輸送能を有する単量体を挙げることができ、特にNーピニルカルバゾールが好ましい。これらの共重合性単量体は、1種単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることができる。

[0032]

【化11】

【0033】特定のカルバゾール系重合体の重量平均分子量は、例えばゲルパーミエーションクロマトグラフ法によるポリスチレン換算で1000~1000000、特に5000~30000であることが好ましい。この重量平均分子量が1000未満である場合には、当該重合体が耐熱性、薄膜状態における安定性および機械的強度が不十分なものとなることがある。一方、この重量平均分子量が10000を超える場合には、当該を対分子量が100000を超える場合には、当該を対分子量が10を湿式法により形成する際に、ハンドリング性が低下し、また、正孔輸送層10を湿式法により形成する際に、ハンドリング性が低下し、また、正孔輸送層形成溶液の糸引き性が生じるため、好ましくない。また、重量平均分子量との比MW/Mnは、特に限定されるものではないが、分子量のそろった重合体、すなわち比MW/Mnが比較的小さいものが好ましい。

【0034】特定のカルバゾール系重合体は、特定単量体または特定単量体と共重合性単量体との混合単量体を、適宜の重合法、例えばラジカル重合法、アニオン重合法またはカチオン重合法で重合することにより製造することができる。また、分子量分布の狭いカルバゾール系重合体を得るためには、リビングラジカル重合法、リビングアニオン重合法またはリビングカチオン重合法が用いられる。

【0035】通常のラジカル重合法によって特定のカルバゾール系重合体を得る場合には、アゾピスイソプチロニトリル(AIBN)などのアゾ化合物、過酸化ベンゾイル(BPO)などの過酸化物、テトラエチルチウラムジスルフィドなどのジチオカルバメート誘導体などの公知のラジカル開始剤を重合触媒として用いたラジカル重50合法を利用することができる。また、リビングラジカル

重合法によって特定のカルバゾール系重合体を得る場合 には、2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジン -N-オキサイド (TEMPO) などのN-オキシラジ カルと、上記のラジカル重合開始剤とを組み合わせた触 媒系によるリビングラジカル重合法、アトムトランスフ ァー重合などによるリビングラジカル重合法を利用する ことができる。このようなラジカル重合触媒の使用割合 は、単量体1モルに対して1~0.0001モルであり る。このようなラジカル重合法において、重合溶媒とし ては、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、 N-メチルピロリドンなどのアミド系溶媒、ベンゼン、 トルエン、キシレン、ヘキサン、シクロヘキサンなどの 炭化水素系溶媒、γープチロラクトン、乳酸エチルなど のエステル系溶媒、シクロヘキシルベンゾフェノン、シ クロヘキサノン、2-エチルペンタノン、エチルイソア ミルケトンなどのケトン系溶媒、テトラヒドロフランな どの環状エーテルやジエチレングリコールジメチルエー テルなどの脂肪族エーテル類などのエーテル系溶媒を用 いることができる。また、反応温度は、例えば0~20 0℃であり、その反応時間は、例えば0.5~72時間 20 である。

【0036】通常のアニオン重合法によって特定のカル バゾール系重合体を得る場合には、例えば、ナフチルナ トリウムなどのアルフィン触媒、メチルリチウム、エチ ルリチウム、ブチルリチウムなどのアルキルリチウム、 フェニルリチウムなどのアリールリチウム、ジエチル亜 鉛などのアルキル亜鉛、リチウムアルキルマグネシウ ム、リチウムアルキルバリウムなどのアート錯体などの アルカリ金属、アルカリ土類金属などの金属による有機 金属化合物をアニオン重合触媒として用いたアニオン重 30 合法を利用することができる。特に、アニオン重合触媒 としては、n-プチルリチウム、sec-プチルリチウ ム、フェニルリチウムなどの有機リチウム化合物を用い ることが好ましい。また、リビングアニオン重合法によ って特定のカルバゾール系重合体を得る場合には、ブチ ルリチウム、エチルリチウム、エチルナトリウムなどの 触媒によるリビングアニオン重合法を利用することがで きる。このようなアニオン重合触媒の使用割合は、単量 体1モルに対して1.0~0.0001モルである。こ のようなアニオン重合法において、重合溶媒としては、 ベンゼン、トルエン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキ サンなどの炭化水素、テトラヒドロフラン、ジオキサン などのエーテル化合物などを用いることができる。ま た、反応温度は、例えば-50~100℃であり、その 反応時間は、例えば0.25~48時間である。

【0037】通常のカチオン重合法によって特定のカルバゾール系重合体を得る場合においては、トリフルオロボレート、四塩化錫などのルイス酸、硫酸、塩酸などの無機酸、カチオン交換樹脂などの公知のカチオン重合触媒を用いたカチオン重合法を利用することができる。ま 50

た、リビングカチオン重合法によって特定のカルバゾール系重合体を得る場合には、HI、HI-ZnI,などの触媒によるリビングカチオン重合法を利用することができる。このようなカチオン重合触媒の使用割合は、単量体1モルに対して0.01~0.0001モルである。このようなカチオン重合法において、重合溶媒としては、メチレンクロライド、クロロベンゼンなどに代表されるハロゲン化炭化水素類、ジブチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランなどの環状エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランなどの環状エーテル類、アセトニトリル、ニトロベンゼンなどの高極性溶媒などを用いることができる。また、反応温度は、例えば0.5分~24時間である。

【0038】本発明の有機EL素子においては、正孔輸送層10は、特定のカルバゾール系重合体のみにより構成されていても、特定のカルバゾール系重合体と、当該特定のカルバゾール系重合体以外の重合体(以下、「他の重合体」という。)とにより構成されていてもよい。ここで、特定のカルバゾール系重合体は、1種単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることができる。

【0039】正孔輸送層10を特定のカルバゾール系重

合体と他の重合体とにより形成する場合には、全重合体 における特定構造単位の含有割合が5質量%以上、特に 10質量%以上であることが好ましい。特定構造単位の 含有割合が5質量%未満である場合には、得られる有機 EL素子は、発光開始電圧が高いものとなりやすく、ま た、発光効率が低く、耐久性も低いものとなりやすい。 【0040】正孔輸送層10を構成する他の重合体とし ては、例えばポリビニルカルバゾール、ポリ (4-ビニ ルフェニル)カルバゾール、ポリビニルトリフェニルア ミン、ピニルカルバゾールと2-(4-ピニルフェニ ル) -5-ナフチル-1, 3, 5-オキサジアゾールと の共重合体などの公知の正孔輸送能を有する重合体など を挙げることができ、好ましくはポリ(4-ビニルフェ ニル)カルバゾール、ポリビニルトリフェニルアミン、 ピニルカルパゾールと2-(4-ピニルフェニル)-5 -ナフチル-1、3、5-オキサジアゾールとの共重合 体を挙げることができる。これらの他の重合体は、1種 単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることができ 40 る。

【0041】また、正孔輸送層10には、種々の染料、レーザー色素などが含有されていてもよく、その割合は、正孔輸送層10を構成する全材料の0.1~10質量%であることが好ましい。このような染料、レーザー色素などが正孔輸送層10中に含有されることにより、得られる有機EL素子は、発光が促進されると共に、一層長い使用寿命を有するものとなる。

【0042】発光層15を構成する発光材料としては、 トリスキノリノラートアルミナムに代表されるヒドロキ シキノリンの金属錯化物や、ヒドロキシベンズオキサゾ

ール、ヒドロキシベンズチアゾールの金属錯化物などを用いることができる。陰極層3としては、仕事関数の小さい(例えば4eV以下)材料よりなるもの、例えばアルミニウム、カルシウム、マグネシウム、リチウム、インジウム等よりなる金属膜、またはこれらの金属の合金膜、またはこれらの金属と他の金属との合金膜などを用いることができる。正孔輸送層10および発光層15の各々の厚みは、特に限定されるものではないが、通常、10~1000nm、好ましくは50~200nmの範囲で選択される。

【0043】このような有機EL素子は、例えば以下のようにして製造することができる。先ず、透明基板1の表面に、陽極層2を形成し、この陽極層2の表面に、特定のカルバゾール系重合体および必要に応じて用いられるその他の材料が適宜の有機溶剤中に溶解されてなる正孔輸送層形成溶液を塗布し、得られた塗布膜を加熱処理することにより、当該塗布膜中の有機溶剤が除去されて正孔輸送層10が形成される。次いで、正孔輸送層10の表面に発光層15を形成し、その後、発光層15の表面に陰極層3を形成し、以て、図1に示す構成の有機E20L素子が製造される。

【0044】以上において、陽極層2を形成する方法としては、真空蒸着法またはスパッタ法などを利用することができる。また、ガラス基板などの透明基板の表面に例えばITO膜が形成されてなる市販の材料を用いることもできる。

【0045】正孔輸送層形成溶液を調製するための有機溶剤としては、正孔輸送層10を形成するための材料

(特定のカルバゾール系重合体および必要に応じて用い られるその他の材料)を溶解し得るものが用いられ、そ 30 の具体例としては、クロロホルム、クロロベンゼン、テ トラクロロエタン等のハロゲン化炭化水素、ジメチルホ ルムアミド、N-メチルピロリドン等のアミド系溶剤、 乳酸エチル、ペグミア、エチルエトキシプロピオネー ト、メチルアミルケトンなどが挙げられる。これらの有 機溶剤は、単独でまたは2種以上を組み合わせて用いる ことができる。 これらの中では、均一な厚みを有する 薄膜が得られる点で、適当な蒸発速度を有するもの、具 体的には沸点が70~150℃程度の有機溶剤を用いる ことが好ましい。有機溶剤の使用割合は、正孔輸送層1 40 0を形成するための材料の種類によって異なるが、通 常、正孔輸送層形成溶液中の正孔輸送層10を形成する ための材料の濃度が0.1~10重量%となる割合であ る。また、正孔輸送層形成溶液を塗布する手段として は、例えばスピンコート法、ディッピング法、ロールコ ート法などを利用することができる。

【0046】また、発光層15を形成する方法としては、(1)発光材料を、正孔輸送層10の表面に真空蒸着することにより、発光層15を形成する乾式法、

(2) 発光材料が適宜の有機溶剤中に溶解されてなる発 50 ているため、ホール(正孔)の素抜けが防止されると共

光層形成溶液を、正孔輸送層15の表面に塗布して加熱 処理することにより、発光層15を形成する湿式法など を利用することができる。湿式法を利用する場合におい て、発光層形成溶液を調製するための有機溶剤として は、発光材料を溶解し得るものであれば、種々のものを 用いることができ、その具体例としては、トルエン、キ シレン等の芳香族炭化水素類、メチルイソプチルケト ン、シクロヘキサノン等のケトン類、乳酸エチル、ィー プチロラクトン等のエステル類、N-メチルピロリドン 等のアミド類、2-エチルヘキサノール等のアルコール 類、テトラクロロエタン等のハロゲン化合物などが挙げ られる。有機溶剤の使用割合は、発光材料の種類によっ て異なるが、通常、発光層形成溶液中の発光材料の濃度 が0.5~10重量%となる割合である。発光層形成溶 液を塗布する手段としては、例えばスピンコート法、デ ィッピング法、ロールコート法などを利用することがで きる。また、陰極層3を形成する方法としては、真空蒸 着法またはスパッタリング法などを利用することができ る。

【0047】上記の第1の実施の形態に係る有機EL素子においては、直流電源5により、陽極層2と陰極層3との間に直流電圧が印加されると、正孔輸送層10および発光層15が発光し、この光は陽極層2およびガラス基板1を介して放射される。このような構成の有機EL素子は、正孔輸送層10が、特定のカルバゾール系重合体を含有してなるため、発光開始電圧が低く、発光効率が高く、しかも、耐久性に優れたものである。

【0048】図2は、本発明の第2の実施の形態に係る 有機EL素子の構成を示す説明用断面図である。この有 機EL素子は、発光層15上に、電子輸送層20が設け られ、この電子輸送層20上に、陰極層3が設けられて いること以外は、第1の実施の形態に係る有機EL素子 と同様の構成である。電子輸送層20を構成する材料と しては、8-ヒドロキシキノリン誘導体等のキノリン系 化合物の金属錯体、ピスナフチルオキサジアゾール、p - t - ブチルフェニル - ピフェニル - オキサジアゾー ル、2-ナフチル-5-フェニル-オキサジアゾールな どのオキサジアゾール系化合物、またはこれらの残基を 側鎖に含有するポリマーなどを用いることができる。こ のような電子輸送層20は、真空蒸着法、スパッタ法な どの乾式法、電子輸送材料を適宜の溶剤に溶解した後、 この溶液を、スピンコート法、ディップ法、インクジェ ット法、印刷法等により塗布して乾燥させる湿式法によ り形成することができる。特に、上記の電子輸送材料 と、アルカリ金属若しくはアルカリ土類金属とを共蒸着 することによって、電子輸送層20を形成することが好 ましい。この第2の実施の形態に係る有機EL素子によ れば、前述の第1の実施の形態に係る有機EL素子と同 様の効果が得られる。また、電子輸送層20が形成され

に、電子の輸送がスムーズとなり、発光開始電圧が一層 低下し、更に、発光効率の一層の向上を図ることができ る。

【0049】図3は、本発明の第3の実施の形態に係る 有機EL素子の構成を示す説明用断面図である。この有 機EL素子は、電子輸送層20上に、電子注入層25が 設けられ、この電子注入層25上に、陰極層3が設けら れていること以外は、第2の実施の形態に係る有機EL 素子と同様の構成である。電子注入層25を構成する材 料としては、LiF、MgF,、CsF等の金属フッ化 10 物、AlO,、SrO等の金属酸化物、アルミニウム等 の金属の錯体などの化合物から、アノードおよび電子輸 送層を構成する材料の仕事関数、LUMOレベルを考慮 して適宜選択することができるこの電子注入層25は、 電子輸送層20の表面全面に形成されていても、当該表 面に点在した状態で形成されていてもよく、また、その 厚みは、0.1~20nm程度でよい。このような電子 注入層25は、真空蒸着法、スパッタ法などの乾式法に より形成することができる。この第3の実施の形態に係 る有機EL素子によれば、前述の第1の実施の形態およ 20 び第2の実施の形態に係る有機EL素子と同様の効果が 得られる。また、電子注入層25が形成されているた め、アノードからの電子の注入がスムーズとなり、発光 開始電圧が一層低下し、更に、発光効率の一層の向上を 図ることができる。

【0050】図4は、本発明の第4の実施の形態に係る 有機EL素子の構成を示す説明用断面図である。この有 機EL素子は、陽極層2上に、正孔注入層30が設けら れ、この正孔注入層30上に、正孔輸送層10が設けら れていること以外は、第1の実施の形態に係る有機EL 素子と同様の構成である。正孔注入層30を構成する材 料としては、銅フタロシアニン、ポリアニリン、ポリチ オフェン、商品名「PEDOT」(バイエル社製)で市 販されているポリエチレンジオキシチオフェンとポリス チレンスルホン酸との錯体などを用いることができる。 このような正孔注入層30は、真空蒸着法、スパッタ法 などの乾式法、電子輸送材料を適宜の溶剤に溶解した 後、この溶液を、スピンコート法、ディップ法、インク ジェット法、印刷法等により塗布して乾燥させる湿式法 により形成することができる。また、その厚みは、1~ 40 100 nmである。この第4の実施の形態に係る有機 E L素子によれば、前述の第1の実施の形態に係る有機E L素子と同様の効果が得られる。また、正孔注入層30 が形成されているため、ホールの注入障害を防止するこ とができる。

【0051】図5は、本発明の第5の実施の形態に係る 有機EL素子の構成を示す説明用断面図である。この有 機EL素子は、発光層15上に、電子輸送層20が設け られ、この電子輸送層20上に、陰極層3が設けられて いること以外は、第4の実施の形態に係る有機EL素子 50 と同様の構成である。電子輸送層20を構成する材料としては、第2の実施の形態に係る有機EL素子と同様のものを用いることができる。この第5の実施の形態に係る有機EL素子によれば、前述の第1の実施の形態、第2の実施の形態および第4の実施の形態に係る有機EL素子と同様の効果が得られる。

【0052】図6は、本発明の第6の実施の形態に係る有機EL素子の構成を示す説明用断面図である。この有機EL素子は、電子輸送層20上に、電子注入層25が設けられ、この電子注入層25上に、陰極層3が設けられていること以外は、第5の実施の形態に係る有機EL素子と同様の構成である。電子注入層25を構成する材料としては、第3の実施の形態に係る有機EL素子と同様のものを用いることができる。この第6の実施の形態に係る有機EL素子によれば、前述の第1の実施の形態に係る有機EL素子と同様の効果が得られる。

[0053]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明するが、 本発明はこれらに限定されるものではない。なお、以下 において、「部」は、「質量部」を意味する。

【0054】〔カルバゾール誘導体の合成〕

(誘導体合成例1) 還流装置付きのフラスコに、出発物質としてカルバゾール20gと、メタル化剤として水酸化カリウム15gと、ニトロベンゼン80ミリリットルとをこの順で加えて室温で撹拌した後、この系を撹拌しながら1時間かけて80℃に昇温し、さらに80℃で1時間撹拌した後、その系を直ちに90℃に昇温して1.5時間撹拌することにより反応溶液を得た。得られた反応密液を冷却した後に濾過し、得られた反応生成物を酢酸に溶解して再結晶させることにより、反応生成物15gを回収した。得られた反応生成物は、N-(p-ニトロフェニル)カルバゾール(以下、「化合物(1)」という。)であることが確認された。

【0055】滴下ロート付き3ロフラスコに、化合物 (1)5gと、酢酸80ミリリットルとを仕込み、化合物 (1)を酢酸に溶解した後、この系に臭素8.2gを室温で滴下して5時間反応させることにより反応溶液を得た。得られた反応溶液を氷水400ミリリットル中に注ぎ、反応生成物を析出して回収し、それをテトラヒドロフラン (THF)に溶解して再結晶することにより、反応生成物7gを得た。得られた反応生成物は、3,6ージプロム [N-(p-ニトロフェニル)カルパゾール](以下、「化合物(2)」という。)であることが確認された。

【0056】不活性ガスの雰囲気中で還流装置付き3ロフラスコ内において、化合物(2)5gと、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(Pd.(dba),)3100mgと、ナトリウムーtープトキシド3gとを、mーキシレン300ミリリットルに溶解さ

24

せ、これにm-トリルフェニルアミン6. 2 gと、トリス(t-ブチル)フォスフィン9 1 mgとを添加して室温で撹拌した後、その系を1 2 0  $\mathbb{C}$  で 2 時間加熱することによって反応を行った。反応溶液を高速液体クロマトグラフィー(HPLC)により分析して反応が終了したことを確認し、当該反応溶液を食塩水で洗浄し、その後、エーテルによって抽出、次いで脱水・乾燥処理した後、溶媒を除去し、反応物(固体)を得た。その反応物をアセトンに溶解させ、メタノールを用いて沈殿精製することにより、反応生成物6 gを回収した。得られた反応生成物は、3 , 6 -  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$ 

【0058】化合物(4)3.1gと、メタクリロイルクロライド0.53gとを、当該化合物(4)の2倍のモル量のトリエチルアミン(脱HC1剤)の存在下で反応させた後、生成したトリエチルアミン塩酸塩および残存したトリエチルアミンを除去することにより、反応生成物を得た。得られた反応生成物は、前記式(a)で表30されるカルパゾール誘導体(以下、「誘導体(1)」という。)であることが確認された。また、誘導体(1)の収率は85%であった。

【0059】 (誘導体合成例2) 合成例1と同様にして 化合物(4)を合成し、この化合物(4)5gを、滴下 ロート付きフラスコ内においてトルエンに溶かし、この ・溶液に2-イソシアナートエチルメタクリレート1.3 gを-70℃で滴下接触させた後、この系の温度を徐々 に30℃に上げて反応を完結させた。なお、この反応は 定量的であった。得られた反応溶液をカラムを用いて分 離することにより、反応生成物を得た。得られた反応生 成物は、前記式(b)で表されるカルバゾール誘導体 (以下、「誘導体(2)」という。)であることが確認 された。また、誘導体(2)の純度は98%であった。 【0060】〔特定のカルバゾール系重合体の合成〕 〈重合体合成例1〉容積50ミリリットルの耐圧ピンの 内部を窒素ガスで置換した後、この耐圧ピン内に、窒素 気流下で誘導体(1)20ミリモルと、N,N-ジメチ ルホルムアミド10ミリリットルとを仕込み、誘導体

(1) をN, N-ジメチルホルムアミドに溶解させた。

この溶液を攪拌しながら、当該溶液にラジカル重合触媒としてアゾビスイソブチロニトリル2ミリモルを添加し、この系を室温から70℃に上昇させて反応温度70℃、反応時間18時間の条件でラジカル重合を行うことにより、重合体溶液を得た。得られた重合体溶液を、その50倍の量のメタノール中に投入することによって重合体を凝固させることにより、重合体を回収した。この重合体を常法により再沈精製し、その後、50℃で1日間減圧乾燥した。以下、得られた重合体を重合体(A-1)という。得られた重合体(A-1)は、前記式

(a) で表される特定構造単位よりなるカルバゾール系重合体であることが確認された。また、重合体(A-1)の重量平均分子量Mwは、ゲルパーミエーションクロマトグラフ法(溶媒:テトラヒドロフラン)によるポリスチレン換算で、10300であり、重量平均分子量と数平均分子量との比Mw/Mnは1.5であった。

【0061】〈重合体合成例2〉誘導体(1)20ミリモルの代わりに誘導体(2)20ミリモルを用いたこと以外は、重合体合成例1と同様にして重合体を得た。以下、得られた重合体を重合体(A-2)という。得られた重合体(A-2)は、前記式(b)で表される特定構造単位よりなるカルバゾール系重合体であることが確認された。また、重合体(A-2)の重量平均分子量MWは、ゲルパーミエーションクロマトグラフ法(溶媒:テトラヒドロフラン)によるポリスチレン換算で、2800であり、重量平均分子量と数平均分子量との比MW/Mnは1.65であった。

【0062】〈重合体合成例3〉誘導体(1)20ミリモルの代わりに誘導体(2)20ミリモルを用い、また Nービニルカルバゾール20ミリモルを共に用いたこと 以外は、重合体合成例1と同様にして重合体を得た。以下、得られた重合体を重合体(A-3)という。また、このカルバゾール系重合体(A-3)は、前記式(b)で表される特定構造単位と、Nービニルカルバゾールに由来する構造単位とよりなるカルバゾール系重合体であることが確認された。また、重合体(A-3)の重量平均分子量Mwは、ゲルパーミエーションクロマトグラフ法(溶媒:テトラヒドロフラン)によるポリスチレン換算で、2000であり、重量平均分子量と数平均分子量との比Mw/Mnは1.65であった。そして、重合体(A-3)は、特定構造単位を50質量%含有するものであった。

【0063】〈重合体合成例4〉誘導体(1)20ミリモルの代わりに誘導体(2)20ミリモルを用い、また前記式(c)で表される化合物10ミリモルを共に用いたこと以外は、重合体合成例1と同様にして重合体を得た。以下、得られた重合体を重合体(A-4)という。また、このカルバゾール系重合体(A-4)は、前記式(b)で表される特定構造単位と、前記式(c)で表される共重合性単量体に由来する構造単位とよりなるカル

バゾール系重合体であることが確認された。また、重合体 (A-4) の重量平均分子量Mwは、ゲルパーミエーションクロマトグラフ法(溶媒:テトラヒドロフラン)によるポリスチレン換算で、28000であり、重量平均分子量と数平均分子量との比Mw/Mnは1.65であった。そして、重合体 (A-4) は、特定構造単位を70質量%含有するものであった。

【0064】〈実施例1〉重合体(A-1)1.5部を、テトラクロロエタン100部に溶解させることにより、正孔輸送層形成溶液を調製した。5cm角のガラス10よりなる透明基板の表面にITO膜(陽極層)が形成されてなる積層材料を用意し、この積層材料におけるITO膜の表面に、調製した正孔輸送層形成溶液を、スピンコーターによって塗布した後、加熱処理による有機溶剤の除去処理を行うことにより、厚みが25nmの正孔輸送層を形成した。次いで、この正孔輸送層上に、真空蒸着法によって厚みが50nmのトリスキノリノラートアルミナムよりなる発光層を形成し、この発光層の表面に、真空蒸着法によって、厚みが200nmで5mm角のマグネシウムおよび銀の合金膜(陰極層)を形成する20ことにより、図1に示す構成の有機EL素子を製造した。

【0065】〈実施例2〉重合体(A-1)の代わりに 重合体(A-2)を用いたこと以外は、実施例1と同様 にして有機EL素子を製造した。

【0066】〈実施例3〉重合体(A-1)の代わりに 重合体(A-3)を用いたこと以外は、実施例1と同様 にして有機EL素子を製造した。

【0067】〈実施例4〉重合体(A-1)の代わりに 重合体(A-4)を用いたこと以外は、実施例1と同様 30 にして有機EL素子を製造した。

【0068】 (実施例5) 重合体 (A-1) の代わり

に、重合体(A-2)と、N-ビニルカルバゾールおよ
び2- (4-ピニルフェニル)-5-ナフチル-1,
3, 4-オキサジアゾールの共重合体(モル比が9:1
で、重量平均分子量 (Mw) が19000のもの) とを
重量比で1対1となる割合で混合したものを用いたこと
以外は、実施例1と同様にして有機EL素子を製造し
た。この有機EL素子は、その正孔輸送層を構成する全
重合体における特定構造単位の割合が50質量%であ
る。

【0069】〈比較例1〉重合体(A-1)の代わりに、N-ポリビニルカルバゾールを用いたこと以外は、 実施例1と同様にして比較用の有機EL素子を製造した。

【0070】 〔有機EL素子の評価〕

(1) 発光開始電圧および最高発光輝度:実施例1~実施例5および比較例1に係る有機EL素子の各々に対し、I T O膜をアノードとし、マグネシウムおよび銀の合金膜をカソードとして直流電圧を印加することにより、発光層を発光させ、その最高発光輝度を輝度計「L S -1 0 0」(ミノルタ社製)により測定した。また、そのときの発光開始電圧を電圧計「R 8 2 4 0」(AD VANTEST社製)により測定した。

(2) 耐久性:実施例1〜実施例5および比較例1に係る有機EL素子の各々について、印加電流を15mAで一定にした状態で発光層を発光させ、発光開始からその発光輝度が初期の発光輝度の2分の1となるまでの時間(半減期)を測定し、比較例1に係る有機EL素子の半減期を100としたときの相対値(以下、「半減寿命」という。)を求めた。以上、結果を下記表1に示す。【0071】

【表1】

	実施例 1	実施例	実施例	実施例	実施例 5	比較例 1
発光開始電圧 (V)	5. 2	4.9	5, 9	4.8	5. 3	10. 3
最高発光輝度 (cd/m²)	17000	20000	12000	15000	16000	6000
半减寿命	>1500	>1500	>1500	>1500	>1500	100

【0072】表1から明らかなように、実施例1〜実施例5に係る有機EL素子は、比較例1に係る有機EL素子に比べて、発光開始電圧が低く、発光輝度が高く、しかも、優れた耐久性を有するものであることが確認された。

### [0073]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 発光開始電圧が低く、発光効率が高く、しかも、耐久性 に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する 50 ことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る有機エレクトロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図である。

【図2】本発明の第2の実施の形態に係る有機エレクトロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図である。

【図3】本発明の第3の実施の形態に係る有機エレクト

8

ロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図である。

【図4】本発明の第4の実施の形態に係る有機エレクトロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図である。

【図5】本発明の第5の実施の形態に係る有機エレクトロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図である。

【図6】本発明の第6の実施の形態に係る有機エレクト

ロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図である。

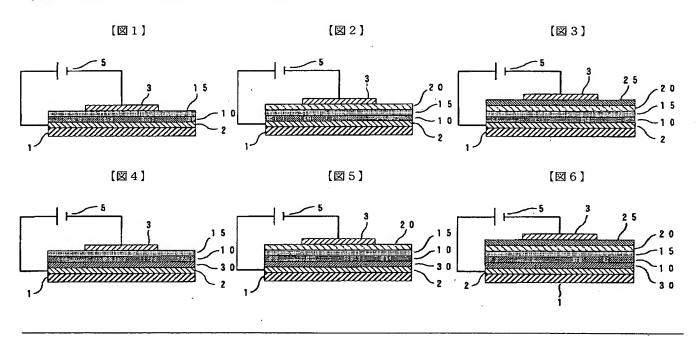
【符号の説明】

 1 透明基板
 2 陽極層

 3 陰極層
 5 直流電源

10正孔輸送層15発光層20電子輸送層25電子注入層

30 正孔注入層



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

C 0 9 K 11/06

690

H 0 5 B 33/14

(72)発明者 榊原 満彦

東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内

(72)発明者 安田 博幸

東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

FΙ

テーマコード(参考)

C 0 9 K 11/06 H 0 5 B 33/14 690

(72)発明者 根来 靖典

東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイエスアール株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB06 AB11 CA01 CB01

DA01 DB03 EB00

4J100 AB07P AL08P AM21P BA27P BA37P BC43P BC65P CA01

DA01 DA04 FA03 JA32